

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第122號

上 訴 人 頤邦科技股份有限公司

代 表 人 吳非艱

陳佩貞 律師

劉昱劭 律師

蔡毓貞 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 易華電子股份有限公司

代 表 人 萬文財

黃耀霆 律師

朱芳儀 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年11月30日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第21號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件係修正行政訴訟法施行前已繫屬於本院，於施行後尚未終結之事件，依行政訴訟法施行法第19條規定，應由本院依舊法即民國112年8月15日修正施行前行政訴訟法（下稱「行政訴訟法」）規定審理。又被上訴人代表人已由洪淑敏變更為廖承威，參加人代表人已由黃嘉能變更為萬文財，均據現任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合。

01 二、上訴人於93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電
02 路裝置」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年4月
03 10日審定並發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專
04 利）。嗣參加人以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第
05 26條第1、2項或第22條第1、2項規定，提起舉發，嗣上訴人
06 就系爭專利請求項3、4提出更正申請，經被上訴人審查，於
07 110年3月25日以（110）智專三（二）04066字第1102027554
08 0號舉發審定書為「109年6月29日之更正事項，准予更正。
09 請求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。
10 上訴人不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109
11 條規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟，聲明：原處分關
12 於系爭專利「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。
13 經原審判決駁回，提起本件上訴。

14 三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用
15 原判決之記載。

16 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

17 (一)依系爭專利請求項3內容，並參酌系爭專利之說明書及圖
18 式，可知因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變
19 得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上
20 端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出
21 ，故系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案
22 於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬
23 度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。

24 (二)證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日（西元2003年1
25 2月5日），為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專
26 利進步性之適格證據。上訴人主張證據未達揭露程度者，不
27 得作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格
28 性」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，
29 顯有誤會。

30 (三)證據5、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：

01 1.依證據5圖1(a)及其說明書第〔0025〕段記載，聚醯亞胺樹
02 脂薄膜對應於「絕緣薄膜」，鎳濺鍍層相當於「基材金屬
03 層」，銅箔對應於「導電性金屬層」，證據5圖1(a)可見鎳
04 濺鍍層係一部分突出於銅線路，該突出部2a如證據5圖1(a)
05 顯示有上端部及側端部，然證據5未揭示將鎳濺鍍層之突出
06 部予以鈍化，故未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配
07 線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案
08 之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特
09 徵。證據4說明書第〔0009〕、〔0014〕、〔0037〕段記
10 載，揭示在蝕刻線路基板後，以氧化劑對基板表面進行清洗
11 處理，使第一金屬層殘留金屬離子成分被氧化處理，得到抑
12 制離子遷移之效果，製造出即使是細線路也具有極佳絕緣信
13 賴性（可靠性）的印刷配線基板，可對應於系爭專利請求項
14 3要件E「基材金屬層所成之配線圖案之基材金屬層上端部表
15 面至少一部份予以鈍化」技術特徵。證據5與證據4均為印刷
16 配線基板之技術領域，具有技術領域關聯性，且其結構皆為
17 絕緣基板上形成下方之第一金屬層（鎳濺鍍層）及上方之第
18 二金屬層（銅層），均使用氧化劑對下方之第一金屬層（鎳
19 濺鍍層）進行處理，具有所欲解決問題共通性及功能或作用
20 共通性，證據4已記載使用氧化劑氧化處理殘留第一金屬層
21 金屬殘餘物，比完全蝕刻金屬殘餘物更可抑制離子遷移之教
22 示或建議，該教示或建議使該發明所屬技術領域中具有通常
23 知識者有動機能結合證據5與證據4之技術內容，將證據5之
24 鎳濺鍍層突出部2a（對應於系爭專利請求項3要件E「自該配
25 線圖案之寬度方向突出而形成之基材金屬層」之技術特
26 徵），使用證據4之教示氧化劑進行「不是完全去除殘留之
27 蝕刻方式，而是清洗處理，使表面微量殘留的金屬離子氧
28 化」之氧化處理，抑制離子遷移，而完成系爭專利請求項3
29 要件E技術特徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中
30 具有通常知識者依據證據5、4之組合所能輕易完成，證據
31 5、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

01 2.系爭專利請求項4至8之附屬技術特徵為證據5、4所揭露，故
02 證據5、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4至8不具進步
03 性。

04 (四)證據6、4之組合足以證明系爭專利請求項3至8不具進步性：
05 證據6未揭示系爭專利請求項3要件E「其中自該配線圖案之
06 寬度方向突出而形成之基材金屬層所成之配線圖案之基材金
07 屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之技術特徵，然證據
08 4可對應於系爭專利請求項3要件E「基材金屬層所成之配線
09 圖案之基材金屬層上端部表面至少一部份予以鈍化」之部分
10 技術特徵。證據6與證據4均為印刷配線基板之技術領域，具
11 有技術領域關聯性，同樣面臨殘存的金屬造成電鍍錫之異常
12 析出，具有所欲解決問題共通性，證據4之教示或建議使該
13 發明所屬技術領域中具有通常知識者有結合動機，將證據6
14 之鎳濺鍍層從銅箔形成之導體圖案側面突出的部分（對應於
15 系爭專利請求項3要件E「自該配線圖案之寬度方向突出而形
16 成之基材金屬層」之部分技術特徵），使用證據4教示氧化
17 劑進行之氧化處理，而完成系爭專利請求項3要件E技術特
18 徵。因此，系爭專利請求項3為所屬技術領域中具有通常知
19 識者依據證據6、4之組合所能輕易完成，證據6、4之組合足
20 以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4至8
21 之附屬技術特徵為證據6、4所揭露，故證據6、4之組合亦足
22 以證明系爭專利請求項4至8不具進步性。

23 (五)證據5、7之組合及證據6、7之組合均不足以證明系爭專利請
24 求項3至8不具進步性。

25 (六)系爭專利請求項3至8有違反核准時專利法第22條第2項規定
26 之情事，舉發成立，系爭專利就此部分應予撤銷，原處分合
27 法等語，駁回上訴人之訴。

28 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：

29 (一)系爭專利申請日為93年12月6日，於102年4月10日經審定准
30 予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時有效之
31 100年12月21日修正公布，102年1月1日施行之專利法（即核

01 准時專利法) 為斷。依核准時專利法第22條第2項規定，發
02 明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術
03 所能輕易完成時，不得取得發明專利。對於獲准專利權之發
04 明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，
05 向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專
06 利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證
07 據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規
08 定，自應為舉發成立之處分。

09 (二)按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於
10 解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專
11 利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解
12 之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖
13 式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作
14 用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實
15 施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不
16 足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說
17 明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之
18 技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範
19 圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準。經
20 查，系爭專利請求項3記載「……該導電性金屬層具有一下
21 端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該
22 配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該
23 基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向『突
24 出』……」原審依請求項記載內容，並進一步參酌系爭專利
25 之說明書及圖式，及系爭專利說明書第12頁第13至20行記載
26 內容，論明：該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就系
27 爭專利請求項3上述文字之客觀意義，可瞭解金屬層上端部
28 形成寬度方向突出，係因從配線圖案寬度方向剖切面上觀
29 察，基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度
30 為長所造成，再參酌系爭專利說明書及圖式，可知具體實施
31 例中，所作成的印刷配線基板之配線圖案，因為基材金屬層

13相較於導電性金屬層20不易被蝕刻，所形成的配線圖案在寬度方向之剖面，比由導電性金屬層20所形成之配線圖案下端部25之寬度為寬，亦即，因蝕刻選擇性，導電性金屬層20會被蝕刻較多、變得較細，基材金屬層13會被蝕刻較少，造成基材金屬層13上端部26就比導電性金屬層20下端部在寬度方向形成為較突出，是系爭專利請求項3中「突出」之解釋，應為「配線圖案於寬度方向剖切，剖切面上可觀察到基材金屬層上端部之寬度比導電性金屬層下端部之寬度為寬」。經核與前開規定及說明相符，並無違誤。又系爭專利請求項3前開所載內容，僅以配線圖案寬度方向剖面中，導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較，予以界定，未記載基材金屬層側端部是否突出、如何突出，亦未記載上端部與側端部之特徵關係，是原審敘明「突出」之解釋應以導電性金屬層下端部之寬度和基材金屬層上端部之寬度的比較為解釋，而不涉及基材金屬層之側端部；系爭專利圖式第6圖所繪示為申請人記載於系爭專利說明書或圖式之實施方式或具體例示，不得以說明書或圖式記載之具體實施方式或實施例限制請求項界定之範圍，上訴人主張將「基材金屬層側端部」納入，「突出」應解釋為「基材金屬層側端部與突出於導電性金屬層寬度方向之基材金屬層上端部之組合結構」云云不可採，亦無不合。上訴意旨主張於材料層之剖切面上，上端部與側端部恆為相鄰關係，系爭專利請求項3既已載明基材金屬層上端部突出於導電性金屬層下端部，與基材金屬層上端部相鄰之基材金屬層側端部，必然亦同時突出於導電性金屬層下端部，原判決有關突出之解釋未納入基材金屬層側端部，違反論理法則、經驗法則，並有理由不備之違法云云，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘為不當，或就原審業已論述或不採之理由，以其主觀見解再事爭執，自無可採。

(三)證據5係關於半導體裝置用捲帶載板，其說明書第〔0025〕段記載「圖1中，首先，對在聚醯亞胺樹脂薄膜1上隔著鎳濺

01 鍍層2設置之銅箔3蝕刻，藉此產生圖樣，形成包含銅線路8
02 之佈線圖案（圖1(a)）。此時，於蝕刻銅時，由於銅被蝕
03 刻，導線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作
04 為突出部2a」；證據6係關於半導體裝置用捲帶載板，證據6
05 說明書第〔0005〕段記載「在聚醯亞胺樹脂薄膜1上施加鎳
06 濺鍍層2後，以電解法形成銅箔3的材料，可達成Tape材料的
07 薄型化」、第〔0006〕段記載「於此兩層TAB Tape形成銅箔
08 之導體圖案的情況下，一般而言係在該銅箔上形成光阻光罩
09 （resist mask）後，同時蝕刻銅箔及鎳濺鍍層。因蝕刻係
10 從銅箔開始溶解，故位於銅箔下方之鎳濺鍍層必然會延遲開
11 始蝕刻。此蝕刻延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所
12 示，鎳濺鍍層為從由銅箔形成之導體圖案的側面突出的狀
13 態」等情，為原審依法認定之事實，核與卷內資料相符。原
14 審參酌證據5、證據6說明書上開段落及證據5、證據6之圖
15 式，論明：證據5圖1(a)可見鎳濺鍍層係一部分突出於銅線
16 路，該突出部2a如證據5圖1(a)顯示有上端部及側端部，所
17 述內容相當於系爭專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層
18 具有一下端部，而該基材金屬層具有一側端部與一上端部，
19 其中，該配線圖案寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成
20 為從在該基材金屬層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度
21 方向突出」之技術特徵；證據6說明書上開段落揭示證據6之
22 鎳濺鍍層2從銅箔3形成之導體圖案側面突出的部分，突出部
23 分如證據6圖4可見有上端部及側端部，所述內容相當於系爭
24 專利請求項3要件C及D「該導電性金屬層具有一下端部，而
25 該基材金屬層具有一側端部與一上端部，其中，該配線圖案
26 寬度方向剖面之基材金屬層上端部，形成為從在該基材金屬
27 層表面析出之導電性金屬層下端部之寬度方向突出」之技術
28 特徵等情，所為認定基礎並非僅憑圖式，亦有參酌相對應之
29 文字說明。而證據5說明書第〔0025〕段既已記載「……導
30 線側面8a殘留有銅線路8下方之鎳濺鍍層2的一部分作為『突
31 出部2a』」，證據6說明書第〔0006〕段記載「……此蝕刻

01 延遲導致如圖5（按：應為圖4之誤載）所示，鎳濺鍍層為從
02 由銅箔形成之導體圖案的側面『突出』的狀態」，證據5圖1
03 (a)、證據6圖4亦可得知上開二段落所述之突出形態，該圖
04 式即屬明確揭露之技術特徵，則原審因而認定證據5、6已揭
05 露系爭專利請求項3要件C及D技術特徵，並無不合。原審復
06 就上訴人主張證據5、6所述突出為線路蝕刻之殘留，與系爭
07 專利請求項3界定特定突出結構不同乙節，論明：證據5圖1
08 (a)、證據6圖4已明確繪示了「特定突出結構之突出殘
09 留」，已明確揭露系爭專利請求項3所界定之特定突出結
10 構，該結構係圖式所明確揭露之內容，非由圖式推測之內
11 容，無論證據5、6說明書之製造方法為何或是否刻意，不影
12 響前述圖式之揭露事實等情，均已詳述其認定之依據及得心
13 證之理由，於法並無違誤。至上訴人所引本院103年度判字
14 第126號判決之案例事實，與本件證據5、6之突出結構已為
15 圖式所明確揭露，案情顯有不同，尚難比附援引。上訴意旨
16 主張原判決漏未斟酌證據5、6有關殘留之文字說明，未慮及
17 圖式僅為示意圖，單依圖式做成與證據5、6文字說明矛盾之
18 認定，與本院上開判決意旨不符，有不適用法規及適用不當
19 之違法云云，均無可採。

20 (四)末查，上訴人雖以其於舉發程序所提蝕刻藥水廠商MEC公司
21 蝕刻殘留之網頁說明，主張線路蝕刻後其基材金屬層突出於
22 導電性金屬層之殘留為一斜坡，無從區分上端部及下端部，
23 而上端部與下端部均為系爭專利強調之技術特徵，系爭專利
24 解釋自有納入側端部之必要云云。然系爭專利「突出」之解
25 釋不應納入側端部，已如前述，而無論MEC公司產品蝕刻殘
26 留形狀為何，仍無礙於證據5、6已明確揭露系爭專利請求項
27 3「突出」之技術特徵。上訴人上開主張，亦無足取。

28 (五)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
29 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
30 回。又「最高行政法院之判決不經言詞辯論為之。但有下列
31 情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：二、涉及專門

01 知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要。」為行政訴訟
02 法第253條第1項第2款所明定。本件雖涉及專門知識，且系
03 爭專利請求項之撤銷影響上訴人之權利，然當事人就相關專
04 門知識均已具狀說明，事證已明，經審酌本件訴訟之情節，
05 本院認無依上訴人聲請行言詞辯論之必要。

06 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
07 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判
08 決如主文。

09 中 華 民 國 113 年 1 月 4 日

10 最高行政法院第二庭

11 審判長法官 陳 國 成

12 法官 簡 慧 娟

13 法官 陳 文 燦

14 法官 林 淑 婷

15 法官 蔡 如 琪

16 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

17 中 華 民 國 113 年 1 月 4 日

18 書記官 林 郁 芳